МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
(ТУСУР)

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента образования
_____ П. Е. Троян
«___» _____ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наноэлектроника

Уровень образования: **высшее образование - бакалавриат**
Направление подготовки / специальность: **11.03.04 Электроника и наноэлектроника**
Направленность (профиль) / специализация: **Промышленная электроника**
Форма обучения: **заочная**
Факультет: **ЗиВФ, Заочный и вечерний факультет**
Кафедра: **ПрЭ, Кафедра промышленной электроники**
Курс: **4**
Семестр: **7, 8**
Учебный план набора 2015 года

Распределение рабочего времени

№	Виды учебной деятельности	7 семестр	8 семестр	Всего	Единицы
1	Лекции	4	2	6	часов
2	Практические занятия	2	4	6	часов
3	Лабораторные работы	0	8	8	часов
4	Всего аудиторных занятий	6	14	20	часов
5	Самостоятельная работа	66	54	120	часов
6	Всего (без экзамена)	72	68	140	часов
7	Подготовка и сдача зачета	0	4	4	часов
8	Общая трудоемкость	72	72	144	часов
				4.0	З.Е.

Контрольные работы: 8 семестр - 1
Зачет: 8 семестр

Томск 2018

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шелупанов А.А.
Должность: Ректор
Дата подписания: 23.08.2017
Уникальный программный ключ:
c53e145e-8b20-45aa-9347-a5e4dbb90e8d

Согласована на портале № 40335

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
протокол № 91 от «19» 4 2018 г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рабочая программа дисциплины составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 11.03.04 Электроника и наноэлектроника, утвержденного 12.03.2015 года, рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ФЭ «___» _____ 20__ года, протокол №_____.

Разработчик:

Доцент каф. ФЭ _____ Ю. В. Сахаров

Заведующий обеспечивающей каф. ФЭ _____ П. Е. Троян

Рабочая программа дисциплины согласована с факультетом и выпускающей кафедрой:

Декан ЗиВФ _____ И. В. Осипов

Заведующий выпускающей каф. ПрЭ _____ С. Г. Михальченко

Эксперты:

Доцент кафедры физической электроники (ФЭ) _____ И. А. Чистоедова

Профессор кафедры промышленной электроники (ПрЭ) _____ Н. С. Легостаев

Согласована на портале № 40335

1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цели дисциплины

формирование теоретических и практических основ, необходимых для расчета, разработки и создания элементов, приборов и устройств и наноэлектроники, а также дальнейшего совершенствования знаний путем изучения научно-техничкой литературы по данной или смежной тематикам

1.2. Задачи дисциплины

– изучение законов физики в низкоразмерных полупроводниковых структурах, изучение технологии изготовления полупроводниковых гетероструктур, изучение основных квантовых эффектов, лежащих в основе приборов и устройств наноэлектроники, изучение структуры и принципов работы приборов и устройств наноэлектроники.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Наноэлектроника» (Б1.Б.15) относится к блоку 1 (базовая часть).

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Квантовая и оптическая электроника, Математика, Материалы электронной техники, Микроэлектроника, Твердотельная электроника, Физика, Физика конденсированного состояния, Химия.

Последующими дисциплинами являются: Проектирование ключевых устройств.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– ОПК-2 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат;

– ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности;

– ПК-1 способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования;

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

– **знать** современное состояние и тенденции развития наноэлектроники и измерительной техники; основной физико-математический аппарат, применяемый при решении задач наноэлектроники; основные физико-математические модели приборов и устройств наноэлектроники, а также основные программные средства для их моделирования.

– **уметь** проводить поиск научно-технической литературы в области микро- и наноэлектроники с использованием информационных технологий; проводить измерения основных параметров приборов и устройств наноэлектроники различного функционального назначения; использовать физико-математический аппарат для решения задач наноэлектроники; строить простейшие физические и математические модели приборов и устройств наноэлектроники различного функционального назначения с использованием программных средств моделирования.

– **владеть** методикой анализа научно-технической литературы в области микро- и наноэлектроники; основными методиками измерения основных параметров приборов и устройств наноэлектроники различного функционального назначения; методикой расчета основных парfметров низкоразмерных структур; основными методиками построения физических и математических моделей приборов и устройств наноэлектроники различного функционального назначения, а также их моделирования с использованием программных средств.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины

Виды учебной деятельности	Всего часов	Семестры

Согласована на портале № 40335

		7 семестр	8 семестр
Аудиторные занятия (всего)	20	6	14
Лекции	6	4	2
Практические занятия	6	2	4
Лабораторные работы	8	0	8
Самостоятельная работа (всего)	120	66	54
Подготовка к контрольным работам	30	20	10
Оформление отчетов по лабораторным работам	8	0	8
Подготовка к лабораторным работам	10	0	10
Проработка лекционного материала	16	12	4
Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	32	20	12
Подготовка к практическим занятиям, семинарам	20	10	10
Выполнение контрольных работ	4	4	0
Всего (без экзамена)	140	72	68
Подготовка и сдача зачета	4	0	4
Общая трудоемкость, ч	144	72	72
Зачетные Единицы	4.0		

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины	Лек., ч	Прак. зан., ч	Лаб. раб., ч	Сам. раб., ч	Всего часов (без экзамена)	Формируемые компетенции
7 семестр						
1 Физические основы наноэлектроники	2	2	0	38	42	ОПК-2, ОПК-7, ПК-1
2 Способы формирования квантово-размерных наноструктур	2	0	0	28	30	ОПК-2, ОПК-7, ПК-1
Итого за семестр	4	2	0	66	72	
8 семестр						
3 Квантовые эффекты	2	2	2	28	34	ОПК-2, ОПК-7, ПК-1
4 Элементы и приборы наноэлектроники	0	2	6	26	34	ОПК-2, ОПК-7, ПК-1
Итого за семестр	2	4	8	54	68	
Итого	6	6	8	120	140	

Согласована на портале № 40335

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Содержание разделов дисциплин (по лекциям)

Названия разделов	Содержание разделов дисциплины (по лекциям)	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
7 семестр			
1 Физические основы наноэлектроники	Волны Де Бройля. Квантовое ограничение. Квантово-размерные объекты и их классификация. Полупроводниковые наногетеростуктуры. Энергетические диаграммы наногетроструктур. Требования, предъявляемые к наногетероструктурам. Двойные гетероструктуры (ДГС). Сверхрешетки. Полупроводниковые сверхрешетки. Виды сверхрешеток. Энергетические диаграммы сверхрешеток. Минизоны. Энергетический спектр электронов в сверхрешетках. Свойства электронного газа в сверхрешетках. Влияние квантоворазмерных эффектов на свойства вещества. Баллистический транспорт.	2	ОПК-2, ОПК-7, ПК-1
	Итого	2	
2 Способы формирования квантово-размерных наноструктур	Общие принципы формирования квантово-размерных структур. Эпитаксия. Формирование квантово-размерных структур методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ). Формирование квантово-размерных структур методом химического осаждения из газовой фазы металлоорганических соединений (MOCVD). Формирование квантовых ям. Формирование квантовых проволок (нитей) геометрическим и электронным способом. Формирование квантовых точек. Механизм процесса самоорганизации при формировании квантовых точек. Размер и форма островков. Вертикальные массивы квантовых точек.	2	ОПК-2, ОПК-7, ПК-1
	Итого	2	
Итого за семестр		4	
8 семестр			
3 Квантовые эффекты	2D-электронный газ в магнитном поле. Целочисленный и дробный квантовый эффект Холла. Эффект Ааронова-Бома. Эффект Штарка. Квантово-размерный эффект Штарка в гетеронаноструктурах с квантовыми ямами. Туннельный эффект. Эффект Джозефсона. Кулоновская блокада. Кулоновская блокада с одним туннельным переходом. Кулоновская блокада с двумя туннельными переходами. Сотуннелирование.	2	ОПК-2, ОПК-7, ПК-1
	Итого	2	

Согласована на портале № 40335

Итого за семестр		2	
Итого		6	

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

Наименование дисциплин	№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо изучение обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин			
	1	2	3	4
Предшествующие дисциплины				
1 Квантовая и оптическая электроника	+	+	+	+
2 Математика	+	+	+	+
3 Материалы электронной техники	+	+	+	+
4 Микроэлектроника	+			+
5 Твердотельная электроника	+	+	+	+
6 Физика	+	+	+	+
7 Физика конденсированного состояния	+	+	+	+
8 Химия		+		
Последующие дисциплины				
1 Проектирование ключевых устройств	+	+	+	+

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий представлено в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Компетенции	Виды занятий				Формы контроля
	Лек.	Прак. зан.	Лаб. раб.	Сам. раб.	
ОПК-2	+	+	+	+	Контрольная работа, Отчет по лабораторной работе, Зачет, Тест
ОПК-7	+	+	+	+	Контрольная работа, Отчет по лабораторной работе, Зачет, Тест
ПК-1	+	+	+	+	Контрольная работа, Отчет по лабораторной работе, Зачет, Тест

6. Интерактивные методы и формы организации обучения

Не предусмотрено РУП.

7. Лабораторные работы

Наименование лабораторных работ приведено в таблице 7.1.

Согласована на портале № 40335

Таблица 7.1 – Наименование лабораторных работ

Названия разделов	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
8 семестр			
3 Квантовые эффекты	Туннельный эффект	2	ОПК-2, ОПК-7, ПК-1
	Итого	2	
4 Элементы и приборы наноэлектроники	Исследование электрических и оптических характеристик светодиодов на основе гетероструктуры с квантовыми ямами	4	ОПК-2, ОПК-7, ПК-1
	Исследование характеристик транзистора с высокой подвижностью электронов (HEMT)	2	
	Итого	6	
Итого за семестр		8	
Итого		8	

8. Практические занятия (семинары)

Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Наименование практических занятий (семинаров)

Названия разделов	Наименование практических занятий (семинаров)	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
7 семестр			
1 Физические основы наноэлектроники	Волны Де Бройля. Квантовое ограничение.	1	ОПК-2, ОПК-7, ПК-1
	Полупроводниковые наногетеростуктуры	1	
	Итого	2	
Итого за семестр		2	
8 семестр			
3 Квантовые эффекты	2D-электронный газ в магнитном поле	1	ОПК-2, ОПК-7, ПК-1
	Туннельный и резонансно-туннельный эффект.	1	
	Итого	2	
4 Элементы и приборы наноэлектроники	Светодиоды и лазеры на гетероструктурах. Квантовые каскадные лазеры.	1	ОПК-2, ОПК-7, ПК-1
	Инфракрасные фотоприемники на основе наногетероструктур	1	
	Итого	2	
Итого за семестр		4	
Итого		6	

Согласована на портале № 40335

9. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

Названия разделов	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции	Формы контроля
7 семестр				
1 Физические основы наноэлектроники	Выполнение контрольных работ	2	ОПК-2, ОПК-7, ПК-1	Зачет, Контрольная работа, Тест
	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	10		
	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	10		
	Проработка лекционного материала	6		
	Подготовка к контрольным работам	10		
	Итого	38		
2 Способы формирования квантово-размерных наноструктур	Выполнение контрольных работ	2	ОПК-2, ОПК-7, ПК-1	Зачет, Контрольная работа, Тест
	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	10		
	Проработка лекционного материала	6		
	Подготовка к контрольным работам	10		
	Итого	28		
Итого за семестр		66		
8 семестр				
3 Квантовые эффекты	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	4	ОПК-2, ОПК-7, ПК-1	Зачет, Контрольная работа, Отчет по лабораторной работе, Тест
	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	6		
	Проработка лекционного материала	4		
	Подготовка к лабораторным работам	4		
	Оформление отчетов по	4		

Согласована на портале № 40335

	лабораторным работам			
	Подготовка к контрольным работам	6		
	Итого	28		
4 Элементы и приборы наноэлектроники	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	6	ОПК-2, ОПК-7, ПК-1	Зачет, Контрольная работа, Отчет по лабораторной работе, Тест
	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	6		
	Подготовка к лабораторным работам	6		
	Оформление отчетов по лабораторным работам	4		
	Подготовка к контрольным работам	4		
	Итого	26		
Итого за семестр		54		
	Подготовка и сдача зачета	4		Зачет
Итого		124		

10. Курсовой проект / курсовая работа

Не предусмотрено РУП.

11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

Рейтинговая система не используется.

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1. Основная литература

1. Борисенко В. Е. Наноэлектроника: учебное пособие для вузов / В. Е. Борисенко, А. И. Воробьева, Е. А. Уткина. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 224 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 81 экз.)

2. Наноэлектроника [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Сахаров Ю. В., Троян П. Е. - 2010. 88 с. - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/537 (дата обращения: 24.07.2018).

12.2. Дополнительная литература

1. Чаплыгин Ю.А. Нанотехнологии в электронике: Монография / Н. И. Боргардт [и др.] ; ред. Ю. А. Чаплыгин ; Московский государственный институт электронной техники. - М. : Техносфера, 2005. - 446 с. - ISBN 5-94836-059-8 (наличие в библиотеке ТУСУР - 20 экз.)

2. Драгунов В.П. Основы наноэлектроники: учебное пособие для вузов / В. П. Драгунов, И. Г. Неизвестный, В. А. Гридчин. - М. : Физматкнига ; М. : Логос ; М. : Университетская книга, 2006. - 494 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 32 экз.)

12.3. Учебно-методические пособия

12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

1. Троян П.Е. Наноэлектроника [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие по аудиторным практическим занятиям и самостоятельной работе / П.Е. Троян, Ю.В. Сахаров. изд-во Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. – 31 с - Режим доступа: http://miel.tusur.ru/images/files/Uchebno-metodicheskii_kompleks%20disciplin/Sakharov/Nanoelectronics_Practics.pdf (дата обращения: 24.07.2018).

2. Троян П.Е. Наноэлектроника [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие по лабораторным работам / П.Е. Троян, Ю.В. Сахаров. – Томск Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и

Согласована на портале № 40335

радиоэлектроники, 2016. – 30 с. - Режим доступа: http://miel.tusur.ru/images/files/Uchebno-metodicheskii_kompleks%20disciplin/Sakharov/Nanoelectronics_lab.pdf (дата обращения: 24.07.2018).

12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

Для лиц с нарушениями зрения:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Научно-образовательный портал ТУСУР - https://edu.tusur.ru/
2. Электронная библиотека - www.elibrary.ru
3. Справочник по наноматериалам - https://nano.nature.com/

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное обеспечение

13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению дисциплины

13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с количеством посадочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.

13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий

Учебная аудитория

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 224 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

Программное обеспечение не требуется.

13.1.3. Материально-техническое и программное обеспечение для лабораторных работ

Лаборатория наноэлектроники и микросистемной техники

учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа

634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 115а ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- Осциллограф АСК 1021;
- Генератор 3-34;
- Вольтметр В7-21;

Согласована на портале № 40335

- Вольтметр В7-26;
- Блок питания Б5-47 (2 шт.);
- Блок питания Б5-10;
- Микроскоп МБС – 9 (2 шт.);
- Источник питания HY 3003 (2 шт.);
- Источник питания UT5003ED (2 шт.);
- Измеритель мощности светового потока TES-133;
- Лабораторные стенды: «Элементы наноэлектроники: оптоэлектронные приборы и устройства», «Элементы наноэлектроники: диоды», «Элементы наноэлектроники: полевые транзисторы»;
- Источник питания GPS 3030 DD;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

Программное обеспечение не требуется.

13.1.4. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы

Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы), расположенные по адресам:

- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.

Состав оборудования:

- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Перечень программного обеспечения:

- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.

13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При занятиях с обучающимися **с нарушениями слуха** предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

При занятиях с обучающимися **с нарушениями зрениями** предусмотрено использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.

При занятиях с обучающимися **с нарушениями опорно-двигательного аппарата** используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.

Согласована на портале № 40335

14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения дисциплины

14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации

Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной компетенций используются оценочные материалы в составе:

14.1.1. Тестовые задания

1. По каким направлениям ограничено движение заряженных частиц в квантовых точках:
а) только по направлению X
б) только по направлению Y
в) только по направлению Z
г) по направлениям XYZ

2. По каким направлениям ограничено движение заряженных частиц в квантовых пленках:
а) по направлениям X и Y
б) только по направлению Y
в) только по направлению Z
г) по направлениям X и Z

3. По каким направлениям ограничено движение заряженных частиц в квантовых нитях (шнурах):
а) по направлениям X и Y
б) по направлению Y и Z
в) только по направлению Z
г) по направлениям X и Z

4. Какое минимальное количество энергетических уровней должно быть в квантовой яме двойной гетероструктуры:
а) 0
б) 1
в) 4
г) 9

5. Максимальная толщина квантовой ямы двойной гетероструктуры не должна превышать:
а) 100 нм
б) длину волны Де Бройля для электрона в квантовой яме
в) длину когерентности
г) 10 нм

6. Максимальное различие постоянных решеток для материалов входящих в гетероструктуру не должно превышать:
а) 1 %
б) 0,1 %
в) 5 %
г) 8 %

7. В какую из сверхрешеток входят полупроводники с одинаковым химическим составом:
а) композиционную
б) легированную
в) модулировано –легированную
г) во все перечисленные.

8. Какой из методов эпитаксии, позволяет получать качественную гетерограницу в гетростуктурах:
а) молекулярно – лучевая

Согласована на портале № 40335

б) химическое осаждение из газовой фазы металлоорганических соединений (MOCVD)
в) жидкостная
г) газовая

9. При каком из типов начальной стадии роста, возникающих при осаждении атомов на подложку из газовой фазы, происходит формирование квантовых точек:
а) Франка- Ван дер Мерве (слоевой рост)
б) Странского – Крастанова (промежуточный тип)
в) Фольмера – Вебера (островковый рост)
г) При всех перечисленных.

10. Как будет изменяться коэффициент прозрачности барьера D, при увеличении массы частицы, если ее энергия остается при этом постоянной
а) уменьшится
б) увеличится
в) останется постоянным
г) может уменьшиться или увеличиться, в зависимости от заряда частицы.

11. В каких плоскостях будут существовать уровни Ландау, если вектор магнитной индукции B направлен вдоль оси Z, перпендикулярной плоскости 2D-газа:
а) в плоскости Z
б) в плоскостях X и Y
в) в плоскостях Y и Z
г) в плоскостях X и Z

12. От чего зависит сопротивление баллистической квантовой проволоки
а) от сечения
б) от длины
в) не зависит от геометрических размеров и
равно нулю
г) от сечения и длины

13. Как измениться длина волны излучения светодиода, изготовленного на основе гетероструктуры с квантовыми ямами, при уменьшении их толщины:
а) уменьшится
б) увеличится
в) останется постоянной
г) может уменьшиться или увеличиться в зависимости от материалов гетероструктуры.

14. Практическое применение целочисленного эффекта Холла
а) эталон силы тока
б) эталон сопротивления
в) эталон напряжение
г) эталон заряда

15. Как изменится поверхностная плотность квантовых точек при увеличении температуры подложки в процессе осаждения
а) увеличится
б) уменьшится
в) останется постоянной
г) может уменьшиться или увеличиться в зависимости от осаждаемых материалов.

16. Какой квантовый эффект лежит в основе работы оптических модуляторов

Согласована на портале № 40335

а) эффект Штарка
б) эффект Джозефсона
в) эффект Холла
г) эффект Зеемана

17. Какой квантовый эффект лежит в основе работы сверхпроводящего квантового интерференционного датчика (СКВИД)
а) эффект Штарка
б) эффект Джозефсона
в) эффект Холла
г) эффект Ааронова – Бома

18. Чем можно объяснить существование целочисленного эффект Холла
а) квантовым ограничением
б) уровнями Ландау
в) туннельным эффектом
г) размерными уровнями

19. От чего зависит число уровней в минизонах сверхрешетки
а) от толщины квантовых ям
б) от числа квантовых ям
в) от толщины барьеров
г) является постоянной величиной

20. Какой из методов эпитаксии может быть использован при изготовлении транзисторов с высокой подвижностью HEMT
а) молекулярно – лучевая
б) химическое осаждение из газовой фазы металлоорганических соединений (MOCVD)
в) жидкостная
г) газовая

14.1.2. Темы контрольных работ

Тема контрольной работы № 2: Квантовые эффекты. Устройства наноэлектроники (Разделы 4-5 рабочей программы). Пример Контрольного задания:

Вариант№1

1. Найти вероятность прохождения D и отражения R для электрона с энергией 2,3 эВ, падающего на потенциальную стенку высотой 2,0 эВ. Эффективную массу принять равной массе электрона в состоянии покоя.

2. Найти вероятность прохождения D и отражения R для электрона с энергией 3 эВ, проходящего через барьер высотой 3,3эВ и протяженностью 4 нм. Эффективную массу принять равной массе электрона в состоянии покоя.

3. Определить длину волны, при которой будет максимум оптического поглощения для сверхрешетки на основе AlAs/GaAs/AlAs. Если толщина квантовых ям составляет 5 нм, барьеров 15 нм.

4. Определить максимальную емкость для туннельного перехода при которой возможен эффект одноэлектронного туннелирования для T=300 K и T=1 K

Примеры задач для контрольной работы приведены в учебно-методическом пособии (п. 2.5 - п.2.12). Варианты контрольной работы приведены в учебно-методическом пособии (п. 3). Учебно-методическое пособие содержат варианты заданий для контрольных работ и индивидуальных заданий. Для самостоятельного изучения рекомендуется список литературы и приводятся справочные материалы.

Тема контрольной работы № 1: Физические основы наноэлектроники (Раздел 1 рабочей программы). Пример Контрольного задания:

Вариант №1

Согласована на портале № 40335

1. Определить длину волны Де Бройля для электрона с энергией 2 эВ.

2. Протон обладает кинетической энергией T = 1 кэВ. Определить дополнительную энергию δT, которую необходимо ему сообщить для того, чтобы длина волн λ де Бройля уменьшилась в три раза.

3. Имеется ДГС на основе AlAs/AlxGa1-xAs/AlAs. Толщина квантовой ямы составляет 4,5 нм. Определить максимальный x при котором в квантовой яме будет один энергетический уровень. Справочные данные для материалов взять из справочника. Эффективные массы считать постоянными и приравнять к средним значениям

4. Имеется ДГС на основе AlAs/InAs/AlAs. Определить минимальную и максимальную толщину квантовой ямы. Справочные данные для материалов взять из справочника.

Примеры задач для контрольной работы приведены в учебно-методическом пособии (п. 2.1-2.4). Варианты контрольной работы приведены в учебно-методическом пособии (п.3). Учебно-методическое пособие содержат варианты заданий для контрольных работ и индивидуальных заданий. Для самостоятельного изучения рекомендуется список литературы и приводятся справочные материалы.

14.1.3. Зачёт

1. По каким направлениям ограничено движение заряженных частиц в квантовых точках:
а) только по направлению X
б) только по направлению Y
в) только по направлению Z
г) по направлениям XYZ

2. По каким направлениям ограничено движение заряженных частиц в квантовых пленках:
а) по направлениям X и Y
б) только по направлению Y
в) только по направлению Z
г) по направлениям X и Z

3. По каким направлениям ограничено движение заряженных частиц в квантовых нитях (шнурах):
а) по направлениям X и Y
б) по направлению Y и Z
в) только по направлению Z
г) по направлениям X и Z

4. Какое минимальное количество энергетических уровней должно быть в квантовой яме двойной гетероструктуры:
а) 0
б) 1
в) 4
г) 9

5. Максимальная толщина квантовой ямы двойной гетероструктуры не должна превышать:
а) 100 нм
б) длину волны Де Бройля для электрона в квантовой яме
в) длину когерентности
г) 10 нм

6. Максимальное различие постоянных решеток для материалов входящих в гетероструктуру не должно превышать:
а) 1 %
б) 0,1 %
в) 5 %
г) 8 %

Согласована на портале № 40335

7. В какую из сверхрешеток входят полупроводники с одинаковым химическим составом:
а) композиционную
б) легированную
в) модулировано –легированную
г) во все перечисленные.

8. Какой из методов эпитаксии, позволяет получать качественную гетерограницу в гетростуктурах:
а) молекулярно – лучевая
б) химическое осаждение из газовой фазы металлоорганических соединений (MOCVD)
в) жидкостная
г) газовая

9. При каком из типов начальной стадии роста, возникающих при осаждении атомов на подложку из газовой фазы, происходит формирование квантовых точек:
а) Франка- Ван дер Мерве (слоевой рост)
б) Странского – Крастанова (промежуточный тип)
в) Фольмера – Вебера (островковый рост)
г) При всех перечисленных.

10. Как будет изменяться коэффициент прозрачности барьера D, при увеличении массы частицы, если ее энергия остается при этом постоянной
а) уменьшится
б) увеличится
в) останется постоянным
г) может уменьшиться или увеличиться, в зависимости от заряда частицы.

11. В каких плоскостях будут существовать уровни Ландау, если вектор магнитной индукции B направлен вдоль оси Z, перпендикулярной плоскости 2D-газа:
а) в плоскости Z
б) в плоскостях X и Y
в) в плоскостях Y и Z
г) в плоскостях X и Z

12. От чего зависит сопротивление баллистической квантовой проволоки
а) от сечения
б) от длины
в) не зависит от геометрических размеров и
равно нулю
г) от сечения и длины

13. Как измениться длина волны излучения светодиода, изготовленного на основе гетероструктуры с квантовыми ямами, при уменьшении их толщины:
а) уменьшится
б) увеличится
в) останется постоянной
г) может уменьшиться или увеличиться в зависимости от материалов гетероструктуры.

14. Практическое применение целочисленного эффекта Холла
а) эталон силы тока
б) эталон сопротивления
в) эталон напряжение

Согласована на портале № 40335

г) эталон заряда

15. Как изменится поверхностная плотность квантовых точек при увеличении температуры подложки в процессе осаждения

а) увеличится

б) уменьшится

в) останется постоянной

г) может уменьшиться или увеличиться в зависимости от осаждаемых материалов.

16. Какой квантовый эффект лежит в основе работы оптических модуляторов

а) эффект Штарка

б) эффект Джозефсона

в) эффект Холла

г) эффект Зеемана

17. Какой квантовый эффект лежит в основе работы сверхпроводящего квантового интерференционного датчика (СКВИД)

а) эффект Штарка

б) эффект Джозефсона

в) эффект Холла

г) эффект Ааронова – Бома

18. Чем можно объяснить существование целочисленного эффект Холла

а) квантовым ограничением

б) уровнями Ландау

в) туннельным эффектом

г) размерными уровнями

19. От чего зависит число уровней в минизонах сверхрешетки

а) от толщины квантовых ям

б) от числа квантовых ям

в) от толщины барьеров

г) является постоянной величиной

20. Какой из методов эпитаксии может быть использован при изготовлении транзисторов с высокой подвижностью HEMT

а) молекулярно – лучевая

б) химическое осаждение из газовой фазы металлоорганических соединений (MOCVD)

в) жидкостная

г) газовая

14.1.4. Темы лабораторных работ

Исследование электрических и оптических характеристик светодиодов на основе гетероструктуры с квантовыми ямами

Исследование характеристик транзистора с высокой подвижностью электронов (HEMT)

Туннельный эффект

14.1.5. Методические рекомендации

Для допуска к зачету должны быть выполнены все лабораторные и контрольные работы предусмотренные планом.

14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.

Согласована на портале № 40335

Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Категории обучающихся	Виды дополнительных оценочных материалов	Формы контроля и оценки результатов обучения
С нарушениями слуха	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы	Преимущественно письменная проверка
С нарушениями зрения	Собеседование по вопросам к зачету, опрос по терминам	Преимущественно устная проверка (индивидуально)
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Решение дистанционных тестов, контрольные работы, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету	Преимущественно дистанционными методами
С ограничениями по общемедицинским показаниям	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы, устные ответы	Преимущественно проверка методами исходя из состояния обучающегося на момент проверки

14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной форме;
- в печатной форме с увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- методом чтения ассистентом задания вслух;
- предоставление задания с использованием сурдоперевода.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге;
- набор ответов на компьютере;
- набор ответов с использованием услуг ассистента;
- представление ответов устно.

Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

Согласована на портале № 40335